

BRF12N65 (CS12N65F)

N-Channel MOSFET/N 沟 MOS 晶体管

用途：用于高频开关电源，电子镇流器，UPS 电源。

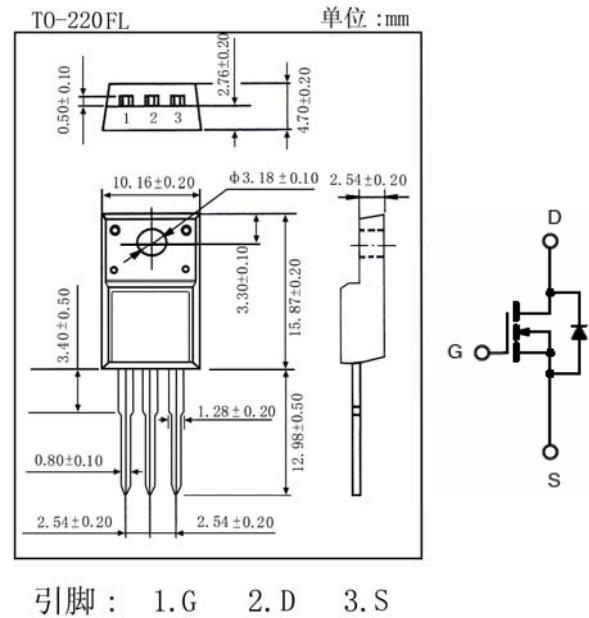
Purpose: High efficiency switch mode power supplies, Electronic lamp ballasts based on half bridge, UPS.

特点:低栅极电荷, 低反馈电容, 开关速度快。

Features: Low gate charge, Low Crss, Fast switching.

极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V _{DSS}	650	V
I _D (Tc=25°C)	12	A
I _D (Tc=100°C)	7.6	A
I _{DM}	48	A
V _{GSS}	±30	V
E _{AS}	880	mJ
E _{AR}	25	mJ
I _{AR}	12	A
R _{θJC}	2.45	°C/W
R _{θJA}	62.5	°C/W
P _D	51	W
T _J , T _{STG}	-55 to 150	°C



电性能参数/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
BV _{DSS}	V _{GS} =0V I _D =250 μA	650			V
I _{DSS}	V _{DS} =650V V _{GS} =0V			1.0	μA
I _{GSS}	V _{GS} =±30V V _{DS} =0V			±100	nA
V _{GS(th)}	V _{DS} =V _{GS} I _D =250 μA	3.0		5.0	V
R _{DS(on)}	V _{GS} =10V I _D =6A		0.71	0.78	Ω
g _{FS}	V _{DS} =40V I _D =6A		13		S
V _{SD}	V _{GS} =0V I _S =12A			1.39	V
C _{iss}	V _{DS} =25V V _{GS} =0V f=1.0MHz		1790	2410	pF
C _{oss}			175	229	
C _{rss}			23	31	
t _{d(on)}	V _{DD} =300V I _D =12A R _G =25 Ω		78	102	ns
t _r			133	175	
t _{d(off)}			233	305	
t _f			104	160	

BRF12N65 (CS12N65F)

